Леонова А. М. ⁽¹⁾, Леонова Н. М. ⁽¹⁾,

Трофимов А. А. ^(1,2), Зайков Ю П (1,2)

(1) Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002 Россия

 (2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, ул. Академи- ческая, 20, Екатеринбург, 620137, Россия

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ

В настоящее время разработка фотоэлектрических элементов вызывает особый интерес из-за возможности модифицировать энергию фотона в электрическую, а также из-за экологичности, модульности и надежности. Кремний - как материал для изготовления солнечных элементов – с момента своего появления привлекает внимание, так как он обладает высокой эффективностью преобразования солнечной энергии, стабильностью и безопасностью.[1]. На текущий момент известны множетсво способов получения кремниевых материалов, используемых в фотоэлектрической промышленности: карбо и магниетермическое восстановление, химическое осаждение из паровой фазы, вытягивание из расплава, кристаллизация тонких пленок аморфного кремния с помощью отжига или электронно-лучевого плавления. В таких методах необходимо использование сложного оборудование и больших энергозатрат, что приводит к низкой производительности и высокой стоимости [2,3]. Электроосаждение в расплавленных солях – это один из альтернативных методов получения кремниевых материалов, из-за низкой стоимости и простоты эксплуатации.

В работе исследуются фотоэлектрохимические свойства кремния, полученные или модифицированные в расплавленных солях. Для электроосаждение кремниевых материалов использовали потенциостат PGSTAT Autolab 302 с программным обеспечением Nova 1.12 (MetrOhm, Нидерланды).

Для модифицирования, а также получения кремния методом электролиза использовали трехэлектродную схему, все опыты проводились в кварцевой ячейке в атмосфере инертного газа. Текстурирование кремния осуществляли в расплаве $K_2WO_3 - Na_2WO_4 - WO_3$ при температуре 700°C с различным соотношением компонентов. Рабочим электродом служила кремниевая пластина с размерами: 16×4×0,4 мм. В качестве противоэлектрода использовалась платиновая фольга, пла-

тиновая проволока применялась как электрод сравнения. Перед катодной обработкой электрод выдерживали в расплаве разное время. Образец выдерживали под катодным перенапряжением 200 мВ в течение 15 с.

Электроосаждение кремния проводили в расплаве KCl-K₂SiF₆ (99% : 1% масс. соответственно). В качестве рабочего электрода использовали стеклоуглеродную пластину с размерами: 10×4,1×2,6 мм, электрод сравнения и противоэлектрод – кремний. Электролиз проводили в течение 8 часов при температуре 792°С при катодной плотности тока 85 мA/см².

Кремниевые пленки также были получены из расплава LiCl– KCl–CsCl–4% масс. K_2SiF_6 при температуре 560°С и потенциале осаждения -0,15 В относительно кремния. Рабочим электродом служила стеклоуглеродная подложка (10×4,1×2,6 мм), в качестве противоэлектрода и электрода сравнения – кремниевая пластина.

Для измерения значений фототока использовали электрохимическую станцию ZiveLAB SP5. Измерения проводили в режиме линейной развертки потенциала. Источником света служил солнечный симулятор Oriel LCS-100 со стандартным фильтром AM1.5G и интенсивностью света 100 мВт/см². Все фотоэлектрохимические измерения проводили по трехэлектродной схеме в кювете из кварцевого стекла толщиной 2 мм. В качестве электрода сравнения использовалась платиновая проволока, погруженная в капилляр Луггина, противоэлектрод – платиновая фольга (15 мм × 15 мм). Электролит представлял собой ацетонитрил (99,9%), содержащий 0,1 М тетрабутиламмонийхлорид (Sigma Aldrich), который действует как фоновый электроэтилвиологен лит. И 0.05 Μ дииодид как окислительновосстановительный агент.

На рисунке 1 представлены данные фотоэлектрохимических испытаний образцов кремниевых материалов, текстурированных в расплаве: $K_2WO_3 - Na_2WO_4 - WO_3$; волокон, полученных в расплаве KCl- K_2SiF_6 (99% : 1% масс.) и пленок из LiCl-KCl-CsCl-4% масс. K_2SiF_6 .

Отклонения плотности тока показывают моменты включения и выключения света на образцах. При смещении потенциала в катодную область прослеживается рост фототока у образцов, текстурированных из расплавов $K_2WO_3 - Na_2WO_4 - WO_3$. Текстурирование образцов прямыми и обратными пирамидами приводит к увеличению фототока до 50% по сравнению с исходной подложкой, также возможно имеет место эффект от осаждения фотоактивного WO_3 на поверхности. У образцов, полученных из расплава LiCl–KCl–CsCl–4% масс. K_2SiF_6 наблюдается слабый отклик на свет, несмотря на высокую чистоту

Большой фоновый ток свидетельствует о покрытия. наличии большого количества не покрытых кремнием участков подложки. Для полученных расплава KCl-K₂SiF₆ наблюдается образцов, ИЗ одинаковая разница между темновым и световым током (примерно 50 мкА/см²) при потенциалах от -0,7 В до -1 В. Также ввиду преимущественно по- рошкообразной структуры полученного осадка и большого количе- ства вызванных этим поверхностных дефектов можно предположить крайне высокую скорость поверхностной рекомбинации заряда, а также необходимость прохождения большого расстояния носителю заряда до точки токосъема. Возможно, при получении сплошных ком- пактных осадков удастся достичь гораздо более высокой плотности фототока.



Рисунок 1. – Зависимость плотности тока от потенциала для образцов, полученных из различных расплавленных солей

Работа выполнена в рамках соглашения № 075-03-2020-582/1 от 18.02.2020 (номер темы 0836-2020-0037)

ЛИТЕРАТУРА

1 Process for Solar Grade Silicon Production by Molten Salt Electrolysis Using Aluminum-Silicon Liquid Alloy / T. Oishi, M. Watanabe, K. Koyama [et al.]. Journal of The Electrochemical Society, 2014.

2 Liquid-Tin- Assisted M olten Salt Electrodeposition of Photoresponsive n-Type Silicon Films / Junjiun Peng, Huayi Yin, Ji Zhao, Xiao Yang [et al.]. Advanced Functional Materials, 2017.